

Circuit for the selection of redundant memory elements and flash EEPROM memory comprising said circuit

Patent number: FR2716566
Publication date: 1995-08-25
Inventor: JEAN-MARIE GAULTIER
Applicant: SGS THOMSON MICROELECTRONICS (FR)
Classification:
 - International: G11C16/06
 - european: G11C29/00R6, G11C29/00R8F4, G11C29/00R8L4, G11C29/00R8L16F
Application number: FR19940002304 19940223
Priority number(s): FR19940002304 19940223

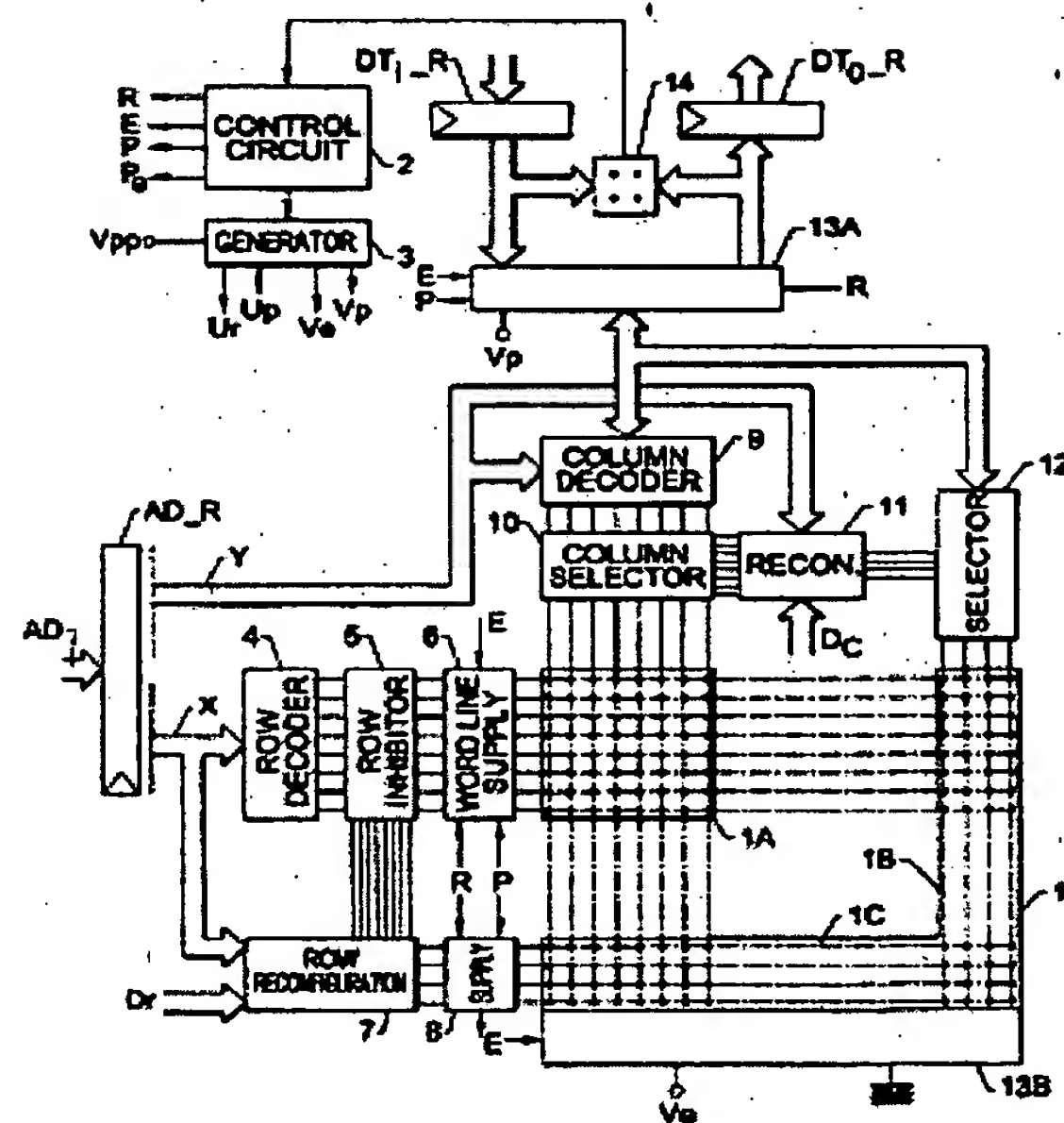
Also published as:

EP0674264 (A)
 US5796653 (A)
 JP7262793 (A)
 EP0674264 (B)

Abstract not available for FR2716566

Abstract of correspondent: **US5796653**

In order to carry out the automatic selection of redundant memory elements (rows or columns) to replace defective elements, the addresses of the elements to be replaced are compared with the current address. In order to improve the reliability by reducing the number of non-volatile memory cells normally containing the addresses of the elements to be replaced, the selection circuit has means to compute certain of these addresses from an actually stored address. Application notably to FLASH EEPROMs.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide



①⑨ BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENTAMT

⑫ Übersetzung der
europäischen Patentschrift

⑤① Int. Cl.⁶:
G 06 F 11/20

⑧⑦ EP 0 674 264 B1

⑩ DE 695 00 143 T 2

②① Deutsches Aktenzeichen:	695 00 143.4
⑧⑥ Europäisches Aktenzeichen:	95 460 007.8
⑧⑥ Europäischer Anmeldetag:	17. 2. 95
⑧⑦ Erstveröffentlichung durch das EPA:	27. 9. 95
⑧⑦ Veröffentlichungstag der Patenterteilung beim EPA:	22. 1. 97
④⑦ Veröffentlichungstag im Patentblatt:	22. 5. 97

③⑩ Unionspriorität: ③② ③③ ③①
23.02.94 FR 9402304

⑦③ Patentinhaber:
SGS-Thomson Microelectronics S.A., Gentilly, FR

⑦④ Vertreter:
Beetz und Kollegen, 80538 München

⑧④ Benannte Vertragsstaaten:
DE, FR, GB, IT

⑦② Erfinder:
Gaultier, Jean-Marie Bernard, F-56100 Lorient, FR

⑤④ Schaltung zum Wählen von Redundanzspeicherbauelementen und diese enthaltende FLASH EEPROM

Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents kann jedermann beim Europäischen Patentamt gegen das erteilte europäische Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch ist schriftlich einzureichen und zu begründen. Er gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr entrichtet worden ist (Art. 99 (1) Europäisches Patentübereinkommen).

Die Übersetzung ist gemäß Artikel II § 3 Abs. 1 IntPatÜG 1991 vom Patentinhaber eingereicht worden. Sie wurde vom Deutschen Patentamt inhaltlich nicht geprüft.

DE 695 00 143 T 2

DE 695 00 143 T 2

Die Erfindung liegt hauptsächlich im Gebiet der nicht-flüchtigen, elektrisch löschbaren integrierten Speicher und betrifft insbesondere die Speicher des Typs "FLASH EEPROM".

Gewöhnlich werden die Speicher mit einer gegebenen Kapazität, beispielsweise 16 Megabits für einen "FLASH EEPROM", in den Handel gebracht. Nun führen die Fertigungsverfahren von integrierten Schaltungen sehr häufig zu Fehlern, insbesondere zu solchen, die die Speicherzellen beeinflussen. Um außerdem eine zu große Anzahl von Ausschussteilen zu vermeiden, sehen die Entwurfsingenieure dieser Schaltungen eine bestimmte Anzahl von redundanten Zellen vor, die dazu bestimmt sind, gegebenenfalls fehlerhafte Zellen zu ersetzen.

Im allgemeinen sind die Speicher in Matrizen organisiert, die aus Zeilen und Spalten von Speicherzellen gebildet sind. Jede Zelle ist dann über eine jeder Zeile zugeordnete Wortleitung und über eine jeder Spalte zugeordnete Bitleitung auswählbar. Aus Gründen der Einfachheit erfolgt in der Praxis die Ersetzung einer fehlerhaften Zelle dadurch, daß die gesamte Zeile oder die gesamte Spalte, die diese Zelle enthält, ersetzt wird. Das Speicherelement - Zeile oder Spalte -, das ersetzt werden soll, hängt vom Typ des erfaßten Fehlers ab.

Diese redundanten Elemente werden nach Prüfungen in Betrieb genommen, die nach der Fertigung jeder integrierten Schaltung ausgeführt werden. Hierzu sind in der integrierten Schaltung programmierbare Rekonfigurationsmittel vorgesehen, derart, daß dann, wenn die Prüfung ein

fehlerhaftes Element aufzeigt, dieses letztere automatisch durch ein Ersetzungselement ersetzt wird, das aus den redundanten Elementen gewählt ist, wobei diese Ersetzung nicht sichtbar und ohne Folgen für die Eigenschaften des Speichers sein muß. In der Praxis enthalten die Rekonfigurationsmittel Schaltungen, um festzustellen, ob die zum Speicher geschickte momentane Adresse jener eines fehlerhaften Elements entspricht, wobei sie dann, wenn dies der Fall ist, ein redundantes Element auswählen, indem das fehlerhafte Element ersetzt wird.

Diese automatische Ersetzung erfolgt gewöhnlich mittels programmierbarer, nichtflüchtiger Register, die dazu vorgesehen sind, die Adressen der fehlerhaften Elemente zu halten. Im Fall eines in Zeilen und Spalten organisierten Speichers ist diese Adresse entweder die Zeilenadresse oder die Spaltenadresse, die den hochwertigen Stellen bzw. den niederwertigen Stellen der vollständigen Adresse entsprechen. Bis jetzt ist jedes redundante Element einem solchen Register und einem Komparator zugeordnet, der an seinen Eingängen den in diesem Register gehaltenen Wert und die momentane Adresse empfängt. Wenn die Prüfoperationen beendet sind, werden die Register auf Werte programmiert, die die Adressen der fehlerhaften Elemente repräsentieren. Falls daher im Betrieb die momentane Adresse mit dem in einem der Register enthaltenen Wert übereinstimmt, liefert der zugeordnete Komparator ein Signal, das die automatische Auswahl des zugeordneten redundanten Elements ermöglicht. Parallel wird die Auswahl des fehlerhaften Elements verhindert.

Diese Lösung erfordert daher die Bereitstellung einer Anzahl von programmierbaren Registern, die gleich der Anzahl redundanter Elemente ist. Andererseits erfordert sie die Programmierung so vieler Register wie erfaßte fehlerhafte Elemente vorhanden sind. Nun stellt das

Vorhandensein von nichtflüchtigen programmierbaren Registern jedoch Probleme hinsichtlich der Zuverlässigkeit aufgrund der Schwierigkeit ihrer Fertigung und ihrer Programmierung.

Auch die Erfindung hat zum Ziel, die Zuverlässigkeit zu verbessern, indem sie eine Lösung vorschlägt, die die Anzahl der programmierbaren Register insbesondere in dem Fall begrenzt, in dem die fehlerhaften Elemente topologisch benachbart sind.

Genauer hat die Erfindung einen elektrisch löschbaren programmierbaren Speicher des Typs "FLASH EEPROM", wie er im Anspruch 1 beansprucht ist, zum Gegenstand.

Das Dokument US-A-5 281 868 offenbart die Verwendung eines Inkrementierers, um ausgehend von der Adresse einer fehlerhaften Spalte die Adresse der physikalisch benachbarten Spalte zu berechnen. Dieses Dokument behandelt jedoch nicht den Fall, in dem die redundanten Elemente selbst fehlerhaft sind. Sie schlägt daher nur vor, daß die Inkrementierer durch Rechenmittel ersetzt werden können, die die Fähigkeit besitzen, einen Ausgang zu liefern, der mit dem Eingang übereinstimmt.

Das Dokument GB-A-2 254 173 betrifft die "FLASH"-Speicher, die mit redundanten Zeilen versehen sind, und behandelt das Problem der Programmierung vor der Löschung ("preconditioning") fehlerhafter Zeilen, insbesondere der aneinandergrenzenden kurzgeschlossenen Zeilen. Um deren Programmierung parallel zu ermöglichen, ist ein Decodierer vorgesehen, der speziell für die systematische Auswahl zweier benachbarter Wortleitungen zum gleichen Zeitpunkt entworfen ist.

Wie im US-Dokument wird der Fall, in dem die redundanten Elemente fehlerhaft sind, nicht angesprochen. Außerdem verwirklicht dieses Dokument gleichzeitige Auswahlvorgänge von benachbarten Zeilen, indem die Decodierer modifiziert werden, und nicht wie die Erfindung, die auf Höhe der Adressen eingreift.

Gegenüber der früheren Lösung weist die Erfindung den Vorteil auf, daß wenigstens ein Teil der nichtflüchtigen Register durch normale Schaltungen ersetzt ist, die eine bessere Zuverlässigkeit aufweisen.

Gemäß einer besonderen Ausführungsform der Erfindung enthalten die Rechenmittel wenigstens eine Inkrementierungsschaltung, die eine Ausgangsgröße liefert, die gleich der Summe aus einem Eingangswert und einem Inkrementierungswert ist.

Der einfachste Fall ist jener, in dem die topologische Reihenfolge der Zeilen und Spalten des Speichers diejenige der numerischen Werte der entsprechenden Adressen ist. Um in diesem Fall mehrere benachbarte Elemente zu ersetzen, kann die Berechnung der Adressen mittels einer einzigen Inkrementierungsschaltung mit einem Inkrementierungswert, der gleich Eins ist, erfolgen. Außerdem kann eine einzige Inkrementierungsschaltung von mehreren Auswahl-schaltungen gemeinsam genutzt werden. Es empfiehlt sich indessen, bei jedem Anlegen der Spannung am Speicher eine Initialisierungsphase vorzusehen, in deren Verlauf die Adressenwerte der zu ersetzenden Elemente nacheinander berechnet und gespeichert werden.

Wenn gewünscht ist, diese Initialisierungsphase zu vermeiden, und gemäß einer besonderen Ausführungsform gemäß der Erfindung enthält die Auswahl-schaltung eine Inkremen-

tierungsschaltung, die jedem der anderen zu ersetzenden Elemente zugeordnet ist.

Vorteilhaft ist die Inkrementierungsschaltung aus einer kombinatorischen Logikschaltung gebildet, die so beschaffen ist, daß sie die Summe aus einem Eingangswert und einem festen Inkrementierungswert bildet.

Selbstverständlich können im Hinblick auf eine höhere Flexibilität im selben Speicher mehrere Auswahlhaltungen vorgesehen sein, deren Inkrementierungsschaltungen verschiedene Inkrementierungswerte zugeordnet sind.

Ein Fehlertyp, der häufig auftritt, ist derjenige, bei dem zwei oder mehr Wortleitungen, die topologisch benachbart sind, kurzgeschlossen sind. Da ein solcher Fehler auch bei redundanten Zeilen entstehen kann, ist die Auswahlhaltung vorteilhaft so beschaffen, daß die Auswahlsignale, die sie liefert, topologisch benachbarte redundante Zeilen auswählen, wobei die Auswahlhaltung dann eine Sperrschaltung für diese Auswahlsignale enthält.

Die Fehler zwischen Leitungen stellen im Fall der "FLASH EEPROM"-Speicher aus Gründen, die weiter unten erläutert werden, ein besonderes Problem dar. Dieser Speichertyp verwendet als Speicherzelle seinen besonderen MOS-Transistor mit schwebendem Gate, dessen Leitungsschwellenwert durch Anlegen geeigneter Spannungen an seine Elektroden modifizierbar ist. Die Programmierung einer Zelle besteht darin, einen hohen Schwellenwert (z. B. 6 Volt) durch Anlegen von Programmierspannungen an das Gate (z. B. 12 Volt) und an den Drain (z. B. 6 Volt) zu erzeugen, wobei die Source auf Masse liegt. Diese Programmierung ist selektiv und wird für jeden Transistor des Speichers gesteuert. Nach Konvention wird gesagt, daß eine program-

mierte Zelle den logischen Wert 0 speichert. Die Löschung einer Zelle besteht darin, einen niedrigen Schwellenwert (z. B. 2 Volt) durch Anlegen einer Löschspannung (z. B. 10 Volt) an die Source des Transistors zu erzeugen, wobei sein Gate auf Masse liegt und sein Drain in den Zustand hoher Impedanz versetzt ist. Im Gegensatz zur Programmierung ist eine Löschoption global, was bedeutet, daß sie auf sämtliche Zellen des Speichers oder auf einen vollständigen Sektor, falls der Speicher in mehreren unabhängigen Sektoren organisiert ist, angewendet wird. Mit der vorangehenden Konvention speichert eine gelöschte Zelle den logischen Wert 1. Das Lesen einer Zelle besteht darin, ihren Leitungszustand zu erfassen. Hierzu wird an ihr Gate eine Lesespannung (z. B. 5 Volt) angelegt, wobei der in die Zelle fließende Strom mit jenem verglichen wird, der in eine Referenzzelle fließt.

Wenn eine Schreiboperation ausgeführt werden soll, d. h. wenn die Programmierung bestimmter Zellen des Speichers modifiziert werden soll, muß vorher die globale Löschung des betreffenden Sektors erfolgen. Aufgrund der globalen Natur der Löschung ist es indessen notwendig, vorher eine gesteuerte Programmierung jeder Zelle des betrachteten Sektors in der Weise vorzunehmen, daß die Drifts und Streuungen der Schwellenwerte nach der globalen Löschung begrenzt werden. Diese Programmierung vor der Löschung wird durch Ausführen eines spezifischen Algorithmus verwirklicht, der die Adressierung befiehlt und die Programmierung jeder der Zellen des Sektors steuert. Selbstverständlich finden diese Operationen auch auf die redundanten Zellen und eventuell auf die fehlerhaften Zellen Anwendung.

Die Programmierung einer gegebenen Zelle besteht darin, die Zeile auszuwählen, zu der sie gehört, indem die Programmiervoltage der Gates an die zugeordnete Wortlei-

tung angelegt wird. Andererseits wird die Spalte dieser Zelle ausgewählt, indem die Programmierspannung der Drains an die entsprechende Bitleitung angelegt wird. Die anderen Zeilen und Spalten werden nicht ausgewählt, was insbesondere zur Folge hat, daß die anderen Wortleitungen mit Masse verbunden sind. Falls unter diesen Bedingungen mehrere Wortleitungen kurzgeschlossen sind (es handelt sich meist um zwei topologisch benachbarte Leitungen), erfolgt normalerweise die Programmierung vor der Löschung der den entsprechenden Zeilen zugehörigen Zellen nicht, so daß für die nach der Löschung erhaltenen Schwellenwerte die Gefahr besteht, daß sie zu niedrig sind (entleerte Zellen). Dieses Problem wird vermieden, wenn vorgesehen ist, gleichzeitig die kurzgeschlossenen Wortleitungen auszuwählen, wenn die Operationen der Programmierung vor der Löschung vorgenommen werden.

Gemäß einem besonderen Aspekt der Erfindung kann diese gleichzeitige Auswahl, die auf die topologisch benachbarten redundanten Zeilen angewendet wird, einfach dadurch verwirklicht werden, daß die Rechenmittel für die Auswahlhaltung so steuerbar sind, daß sie wahlweise einen Wert liefern, der mit ihrem Eingangswert übereinstimmt.

Die Erfindung hat außerdem einen elektrisch löschbaren programmierbaren Speicher des Typs "FLASH EEPROM" zum Gegenstand, der mehrere Auswahlhaltungen, wie sie oben definiert worden sind, enthält.

Weitere Aspekte und Vorteile der Erfindung gehen aus der folgenden Beschreibung mit Bezug auf die Figuren hervor.

- Fig. 1 ist ein Gesamtschema eines Speichers, der redundante Elemente enthält.

- Fig. 2 zeigt die Mittel für die Auswahl der Zeilen des Speichers von Fig. 1.
- Fig. 3 zeigt eine Matrix von Speicherzellen, die Transistoren mit schwebendem Gate verwenden.
- Fig. 4 ist eine genaue Darstellung einer Auswahl-schaltung gemäß der Erfindung.
- Fig. 5 zeigt ein Ausführungsbeispiel der Rechenmittel für die Ausführung der Erfindung.

Fig. 1 zeigt die Hauptbestandteile eines Speichers, in dem Auswahl-schaltungen gemäß der Erfindung verwendet werden können. In einem nicht beschränkenden Beispiel ist der gezeigte Speicher vom Typ "FLASH EEPROM".

Außer den nicht gezeigten Schnittstellen- und Wartungs-schaltungen ist der Speicher im wesentlichen aus einer Matrix 1 von Speicherpunkten, die in Zeilen und Spalten organisiert sind, aus einer Steuerschaltung 2 und aus einem Generator 3 für die Versorgungsspannungen gebildet. Die Steuerschaltung 2 ist eine programmierte Einheit, beispielsweise des Typs "PLA", die sämtliche Schaltungen des Speichers wie beispielsweise den Generator 3 steuert. Die Schaltung 2 hat hauptsächlich die Aufgabe, die Lese-, Löscho- und Programmieroperationen mittels Steuersignalen R, E, P oder Pe, die an die verschiedenen betroffenen Schaltungen gesendet werden, zu steuern.

Der Generator 3 hat die Aufgabe, anhand von äußeren Versorgungs- und Programmierspannungen Vpp die verschiedenen Potentiale Vr, Up, Vp und Ve zu liefern, die für die Lese-, Programmier- bzw. Löschooperationen notwendig sind.

Der Speicher wird durch eine momentane Adresse AD adressiert, die von außerhalb empfangen und von der Schnittstellenschaltung in ein Adressenregister AD_R eingegeben wird. Die mit der äußeren Umgebung ausgetauschten Daten bewegen sich über ein Eingangsdatenregister DTi_R zum Schreiben und über ein Ausgangsdatenregister DTo_R zum Lesen. Die hochwertigen Stellen X der Adresse AD bilden die Zeilenadresse, die der Definition der Zeile dient, die bei einer Lese- oder Schreiboperation auszuwählen ist. Die niederwertigen Stellen Y der Adresse AD bilden die Spaltenadresse, die der Definition der auszuwählenden Spalte dient.

Die Matrix 1 enthält eine Hauptmatrix sowie eine Gesamtheit von redundanten Zeilen 1C und eine Gesamtheit von redundanten Spalten 1D. Diese redundanten Zeilen und Spalten sind dazu vorgesehen, Zeilen und Spalten zu ersetzen, in denen die Zellen im Verlauf der Prüfoperationen als fehlerhaft erkannt worden sind.

Herkömmlicherweise werden die Zeilen der Hauptmatrix in Abhängigkeit von der Zeilenadresse X mittels eines Zeilendecodierers 4 ausgewählt, der an eine Versorgungs- und Verstärkungsschaltung 6 über eine Sperrschaltung 5 Auswahl-signale liefert. Die Verstärkungsschaltung 6 ist dazu vorgesehen, an die Wortleitungen der Matrix 1A geeignete Spannungen für die Lese-, Löscho- oder Programmieroperationen anzulegen. Die Sperrschaltung der Zeilen 5 hat die Aufgabe, die fehlerhaften Zeilen zu deaktivieren, die von einer Zeilen-Rekonfigurationsschaltung 7 ausgewählt werden. Die Schaltung 7, die mit Bezug auf Fig. 2 genauer beschrieben wird, spielt außerdem die Rolle der Auswahl-schaltung für redundante Zeilen 1C und steuert eine Verstärkungsschaltung 8, die dazu dient, die diesen Zeilen zugeordneten Wortleitungen analog wie die Schaltung 6 zu versorgen.

Die Spalten der Hauptmatrix werden in Abhängigkeit von der Spaltenadresse Y mittels eines Spaltendecodierers 9 ausgewählt, der an eine Spalten-Auswahlschaltung 10 angeschlossen ist, die von einer Spalten-Rekonfigurationsschaltung 11 gesteuert wird. Die Schaltung 11 steuert außerdem eine Auswahlschaltung 12 für redundante Spalten 1B. Die Auswahlschaltungen 10, 12 liefern Auswahlsignale, die das Anlegen geeigneter Spannungen an die entsprechenden Bitleitungen bei Lese- oder Schreiboperationen bedingen. Diese Spannungen werden von den Schaltungen 13A und 13B unter den Bedingungen geliefert, die mit Bezug auf Fig. 3 genauer beschrieben werden. Die Schaltung 13A enthält außerdem Leseverstärkungsmittel. Um gleichzeitig mehrere Bits desselben Worts, die mehreren Spalten zugeordnet sind, zu lesen und zu schreiben, sind im allgemeinen mehrere Leseverstärker und mehrere Schreibschaltungen, die parallel arbeiten, vorgesehen.

Ein Komparator 14 ist an Eingänge der Leseverstärker und des Eingangsdatenregisters DTi_R in der Weise angeschlossen, daß die Steuerschaltung 2 über den korrekten Verlauf der Programmieroperationen der Speicherzellen informiert wird. Das Ergebnis dieses Vergleichs wird von der Steuerschaltung 2 berücksichtigt, um die Ausführung ihres Programmieralgorithmus anzupassen.

Fig. 2 zeigt die Gesamtheit der Mittel für die Auswahl der Zeilen der Matrix 1 und zeigt genauer die Rekonfigurationsschaltung 7. Die Schaltung 7 enthält einen Rekonfigurationsspeicher 17, der im wesentlichen aus einem Adressenspeicher 19 und aus Invalidierungszellen 20 gebildet ist. Diese Speicherelemente sind mittels nicht-flüchtiger Zellen gebildet, die (nicht gezeigten) Lesemitteln zugeordnet sind. Diese Zellen sind außerdem durch eine Programmierschaltung 18 programmierbar. Der Adres-

senspeicher 19 ist aus mehreren Registern gebildet, die dazu vorgesehen sind, jeweils einen besonderen Adressenwert der Zeilen zu enthalten, die einer fehlerhaften Zeile der Hauptmatrix 1A entsprechen. Die Invalidierungszellen 20 sind den Zeilen der Matrix 1 zugeordnet, wobei ihre logischen Zustände Hinweise auf die Sperrung der zugeordneten Zeilen bilden. Die Programmierung der Elemente 19 und 20 durch die Schaltung 18 erfolgt als Antwort auf einen Programmierbefehl Pr in Abhängigkeit von Rekonfigurationsdaten Dr, die von den Wartungsschaltungen des Speichers geliefert werden.

Die Zustände der Invalidierungszellen der Zeilen der Hauptmatrix 1A werden an die obenerwähnte Sperrschaltung 5 übertragen. Die Schaltung 5 liefert die Zeilen-Auswahlsignale SR an die Versorgungsschaltung 6 der Wortleitungen WL. Die Auswahl der redundanten Zeilen erfolgt mittels eines Decodierers 15 und einer Sperrschaltung 16, die vorteilhaft mittels Auswahlsschaltungen gemäß der Erfindung verwirklicht sind. Der Decodierer 15 empfängt an seinem Eingang die momentane Zeilenadresse X sowie die besonderen Adressenwerte, die im Adressenspeicher 19 enthalten sind. In Abhängigkeit von diesen Daten liefert der Decodierer 15 an die Sperrschaltung 16 Vergleichssignale HIT, die die Vorauswahlsignale der redundanten Zeilen bilden. Wie bei der Hauptmatrix empfängt die Sperrschaltung 16 die Sperrhinweise, die die Zustände der Invalidierungszellen repräsentieren, welche den redundanten Zeilen zugeordnet sind, und liefert die entsprechenden Auswahlsignale SR. Wie bei der Hauptmatrix steuern die Signale SR die Versorgungsschaltung 8 der Wortleitungen WL.

Die Programmierung des Rekonfigurationsspeichers 17 beruht auf dem folgenden Prinzip. Zunächst werden sämtliche Invalidierungszellen 20 und jene, die den Adressen-

speicher 19 bilden, gelöscht. Wenn eine Zeile der Hauptmatrix als fehlerhaft erfaßt wird, wird ihre Invalidierungszelle programmiert. Der besondere Wert der Adresse dieser Zeile wird dann in eines der Register des Adressenspeichers 19 durch eine selektive Programmierung der Zellen dieses Registers geladen. Zusätzlich wird eine reservierte Zelle dieses Registers in der Weise programmiert, daß es einen Hinweis auf die Gültigkeit der zugeordneten Adresse bildet. Dieser besondere Adressenwert wird anschließend vom Decodierer 15 in der Weise verwendet, die später mit Bezug auf Fig. 4 beschrieben wird. Wenn es sich zeigt, daß eine der redundanten Zeilen, die somit in Betrieb genommen worden ist, selbst fehlerhaft ist, wird anschließend ihre Invalidierungszelle so programmiert, daß die Sperrschaltung 16 informiert wird.

In einer Abwandlung können die Invalidierungszellen der Zeilen der Hauptmatrix unter der Voraussetzung weggelassen werden, daß eine globale Sperrung sämtlicher Zeilen der Hauptmatrix vorgesehen ist, wobei diese globale Sperrung durch die Aktivierung eines beliebigen der Vergleichssignale HIT hervorgerufen wird.

Die Mittel für die Auswahl der Spalten können in einer zum vorangehenden Schema vollkommen analogen Weise verwirklicht sein. Es wird daher keine besondere Beschreibung gegeben.

Bevor die Auswahlschaltung gemäß der Erfindung genauer erläutert wird, empfiehlt es sich, an die Struktur und die Organisation von Matrizen mit schwebendem Gate zu erinnern, welche in den Speichern des Typs "FLASH EEPROM" verwendet werden. Fig. 3 zeigt eine solche Struktur in dem einfachen Fall eines wortweisen Zugriffs auf ein einziges Bit. Die Fälle des wortweisen Zugriffs auf mehrere Bits ergeben sich daraus einfach.

Die Sources der Transistoren sind sämtlich miteinander verbunden und werden sämtlich von einer Source-Versorgungsschaltung 13B versorgt, die bei Lese- und Programmieroperationen das Massepotential oder aber bei Löschoptionen ein Löschpotential V_e (in der Größenordnung von 10 Volt) liefern. Jede Zeile wird durch eine Wortleitung $WL_1, WL_i, WL_{i+1}, WL_n$ gesteuert, die an jedes der Steuergates der Transistoren der Zeile angeschlossen sind. Die Wortleitungen werden durch eine Versorgungsschaltung 6, 8 versorgt, die durch die Zeilen-Auswahlsignale $SR_1, SR_i, SR_{i+1}, SR_n$ gesteuert werden. Für die nicht gewählten Zeilen wie etwa die erste Zeile legt die Versorgungsspannung 6, 8 das Massepotential an die zugeordneten Wortleitungen an. Für die gewählte Zeile (Zeile i) legt die Schaltung 6, 8 an die entsprechende Wortleitung WL_i im Fall einer Programmierung das Potential U_p (in der Größenordnung von 12 Volt), im Fall eines Lesens das Potential U_r (in der Größenordnung von 5 Volt) oder im Fall eines Löschs das Massepotential an. Die Drains der Transistoren jeder Spalte sind mit einer zugeordneten Bitleitung BL_1, BL_2, \dots, BL_n verbunden. Diese Bitleitungen sind an die Lese- und Schreibschaltung 13A angeschlossen, die durch die Spalten-Auswahlsignale SC_1, SC_2, \dots, SC_n gesteuert wird, welche von der Spalten-Auswahlschaltung 10 geliefert werden. Die Bitleitungen der nicht ausgewählten Spalten werden in den Zustand hoher Impedanz versetzt, während jene der ausgewählten Spalte (die erste Spalte) an einen Leseverstärker angeschlossen werden, der im Fall eines Lesens ein binäres Datum B_0 liefert oder aber im Fall einer Programmierung ein Programmierpotential V_p (in der Größenordnung von 6 Volt) empfängt oder aber im Fall eines Löschs in den Zustand hoher Impedanz versetzt wird.

Anhand der vorangehenden Beschreibung kann festgestellt werden, daß die Lese- und Programmieroperationen selektiv für jeden Transistor der Matrix erfolgen, während die Löschooperationen die Gesamtheit der Transistoren betreffen. Aus den obenerwähnten Gründen erfordert die globale Eigenschaft der Löschooperationen eine vorherige Programmierung jedes der Transistoren der Matrix. Die Programmierung eines dieser Transistoren impliziert daher das Anlegen des Programmierpotentials Up an seine Wortleitung (z. B. WL_i), wobei sein Drain mit der Spannung V_p versorgt wird. Außerdem sind die anderen Wortleitungen (z. B. WL_{i+1}) normalerweise mit Masse verbunden. Wenn nun die ausgewählte Wortleitung WL_i schlecht isoliert ist und mit einer anderen Wortleitung, die im allgemeinen benachbart ist, kurzgeschlossen ist, empfängt sie nicht das korrekte Programmierpotential. Daraus folgt, daß die Transistoren der zwei Zeilen, deren Wortleitungen kurzgeschlossen sind, schlecht programmiert werden (zu niedriger Leitungsschwellenwert) und daß bei ihnen nach der globalen Löschung die Gefahr besteht, daß sie entleert sind (negativer Spannungsschwellenwert) und daher selbst dann leiten, wenn sie nicht ausgewählt sind. Daraus folgt, daß die Gefahr besteht, daß die an einer Wortleitung bei einem Lesen anliegende Spannung nicht mehr den Leitungszustand des ausgewählten Transistors repräsentiert. Die Lösung zur Beseitigung dieses Problems besteht darin, eine Programmierung parallel auf die Transistoren der Zeilen auszuüben, deren Wortleitungen kurzgeschlossen sind. Dies kann verwirklicht werden, indem entsprechend die Funktionsweise der letzten Stufe des Zeilendecodierers abgewandelt wird. Später wird ersichtlich, wie diese Abwandlung einfach kraft einer Auswahlhaltung gemäß der Erfindung verwirklicht werden kann, die nun genauer mit Bezug auf Fig. 4 beschrieben wird.

Die Auswahl-schaltung ist im wesentlichen aus einem redundanten Zeilendecodierer 15A und aus einer Sperrschaltung 16A gebildet. Um die Erläuterung zu vereinfachen, ist die in Fig. 4 gezeigte Schaltung dazu vorgesehen, lediglich zwei redundante Zeilen, die topologisch benachbart sind ($k, k + 1$) und durch die Signale SR_k und SR_{k+1} ausgewählt werden können, auszuwählen. Außerdem zeigt Fig. 4 diejenigen Teile des Decodierers 4 und der Sperrschaltung 5, die auf zwei Zeilen ($i, i + 1$) der Hauptmatrix bezogen sind und die durch die Signale SR_i und SR_{i+1} ausgewählt werden können.

Der Decodierer 15A der Auswahl-schaltung enthält einen ersten Komparator 21, der an seinen Eingängen die Adresse der momentanen Zeile X und den besonderen Wert der Zeilenadresse, der im Register RX_k des Adressenspeichers 19 enthalten ist, empfängt. Dieser besondere Wert ist beispielsweise die Adresse X_i der Zeile i der Hauptmatrix. Um die Logik des Decodierers 15A zu vereinfachen, enthält das Register RX_k eine Zelle v_k , deren logischer Zustand die Gültigkeit der im Register RX_k enthaltenen Daten angibt. Der besondere Wert X_i wird andererseits an den Eingang von Rechenmitteln 23 angelegt, die die Summe aus ihrem Eingangswert und einem Inkrementierungswert D bilden können. Ein zweiter Komparator 22 empfängt an seinen Eingängen die momentane Adresse X und den von den Rechenmitteln 23 berechneten Wert. Wenn daher der im Register RX_k enthaltene besondere Wert durch den Zustand der Zelle v_k validiert ist, liefern die Komparatorschaltungen 21 und 22 Vergleichssignale HIT_k bzw. HIT_{k+1} , die an die Sperrschaltung 16A übertragen werden. Unter der Voraussetzung, daß der Invalidierungsanzeiger D_k , der den entsprechenden Zeilen k und $k + 1$ zugeordnet ist, inaktiv ist, bilden die Signale HIT_k und HIT_{k+1} die Auswahl-signale SR_k bzw. SR_{k+1} der redundanten Zeilen k bzw. $k + 1$.

Somit wird als Inkrementierungswert D der Abstand zwischen den Adressen von zwei Zeilen (beispielsweise den benachbarten Zeilen i und $i + 1$) der Hauptmatrix gewählt, wobei die Auswahl-schaltung die redundanten Zeilen k und $k + 1$ anstelle der Zeilen i bzw. $i + 1$ der Hauptmatrix wählt. Selbstverständlich werden die Zeilen i und $i + 1$ vor der Programmierung der entsprechenden Invalidierungs-anzeiger D_i bzw. D_{i+1} deaktiviert.

Wie oben erläutert worden ist, erfordert ein Kurzschluß zwischen zwei (benachbarten) Wortleitungen eine parallele Programmierung vor der Löschung. Es empfiehlt sich daher, diesen Fall vorzusehen, indem die Aktivierung der Auswahl-signale trotz der Invalidierungs-anzeiger zugelassen wird. Für die Zeilen der Hauptmatrix kann diese Zulassung mittels Signalen der Programmierung vor der Löschung P_i und P_{i+1} gemäß dem Schema der in der Figur gezeigten Sperrschaltung 5 erfolgen.

Was die redundanten Zeilen betrifft, kann die parallele Programmierung vor der Löschung einfacher dadurch verwirklicht werden, daß die Rechenmittel 23 so beschaffen sind, daß sie durch ein Signal P_e gesteuert werden können, damit sie einen Ausgangswert liefern, der mit dem Eingangswert übereinstimmt. Wenn daher das Signal P_e aktiv ist, ruft das Auftreten einer momentanen Adresse X , die gleich dem besonderen Wert X_i ist, die gleichzeitige Aktivierung der Vergleichssignale HIT_k und HIT_{k+1} hervor. Da somit der Invalidierungs-anzeiger D_k durch das Signal P_e deaktiviert wird, werden die Zeilen k und $k + 1$ durch die gleichzeitig aktiven Auswahl-signale SR_k und SR_{k+1} gleichzeitig ausgewählt. Selbstverständlich ist diese Möglichkeit der gleichzeitigen Auswahl mehrerer Zeilen vor allem dann nützlich, wenn diese Zeilen topologisch

benachbart sind, weil die Fälle eines Kurzschlusses zwischen entfernten Zeilen viel unwahrscheinlicher sind.

Die eben beschriebene Ausführungsform ist selbstverständlich nicht beschränkend. Es können zahlreiche Varianten, die im Bereich des Wissens des Fachmanns liegen, hinzugefügt werden. Insbesondere kann die Auswahl-schaltung in der Weise abgewandelt werden, daß zusätzliche Zeilen ausgewählt werden, indem andere Rechenmittel und andere Komparatoren vorgesehen werden. Es ist außerdem möglich, die Rechenmittel von mehreren Komparatoren derselben Auswahl-schaltung oder mehrerer verschiedener Auswahl-schaltungen durch geeignete Multiplexierungsmittel, die während einer Initialisierungsphase nach jedem Anlegen der Spannung an den Speicher gesteuert werden, gemeinsam zu nutzen.

Gemäß dem Schema von Fig. 5 können die Rechenmittel vorteilhaft mittels einer Inkrementierungsschaltung 23A verwirklicht sein, die aus einer verdrahteten Logikschaltung gebildet ist, die so beschaffen ist, daß sie einen festen Inkrementierungswert liefert. Dieser Schaltung 23A ist dann ein Multiplexer 23B zugeordnet, der durch das Signal P_e gemäß dem in der Figur gezeigten Schema gesteuert wird.

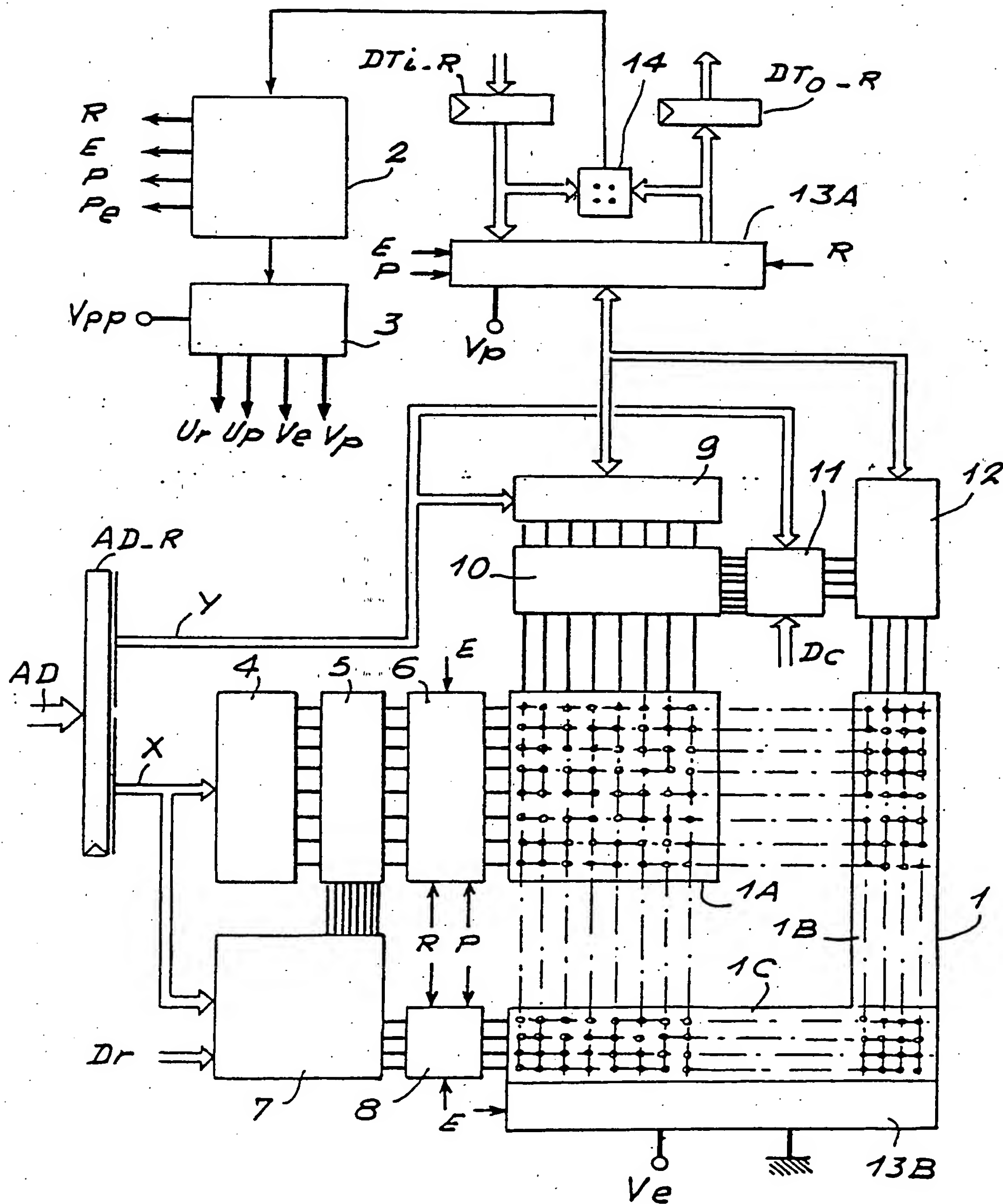
Patentansprüche

1. Elektrisch löschtbarer, programmierbarer Speicher des Typs "FLASH EEPROM", der in Zeilen und Spalten von Speicherzellen organisiert ist, wobei ein "Element" eine Zeile oder eine Spalte bezeichnet, wobei der Speicher mehrere redundante Elemente (1B, 1C) enthält, die durch wenigstens eine AuswahlSchaltung (15A, 16A) auswählbar sind, wobei die redundanten Elemente (1B, 1C) dazu vorgesehen sind, Elemente mit fehlerhaften Zellen zu ersetzen, wobei die zu ersetzenden Elemente durch besondere Werte einer momentanen Adresse (X), die dazu dienen, die Elemente zu adressieren, identifiziert werden, wobei einer dieser besonderen Werte (X_i) in nichtflüchtigen und programmierbaren Speichermitteln (RX_i) enthalten ist, wobei die AuswahlSchaltung (15A, 16A) Rechenmittel (23) zum Berechnen des Adressenwertes ($X_i + D$) wenigstens eines anderen zu ersetzenden Elements in Abhängigkeit von einem Eingangswert, der gleich dem in den Speichermitteln (RX_i) enthaltenen Wert (X_i) ist, sowie Vergleichsmittel (21, 22) zum Vergleichen der momentanen Adresse (X) mit dem gespeicherten Wert (X_i) und mit einem oder mehreren berechneten Adressenwerten ($X_i + D$) und zum Liefern von Vergleichssignalen (HIT_k , HIT_{k+1}), die sich aus den Vergleichen ergeben, enthält, wobei die Vergleichssignale (HIT_k , HIT_{k+1}) die Bewertung der AuswahlSignale (SR_k , SR_{k+1}) von zugeordneten redundanten Elementen konditionieren, wobei die Rechenmittel (23) des Speichers in der Weise steuerbar sind, daß sie selektiv einen Wert liefern, der mit dem Eingangswert übereinstimmt.

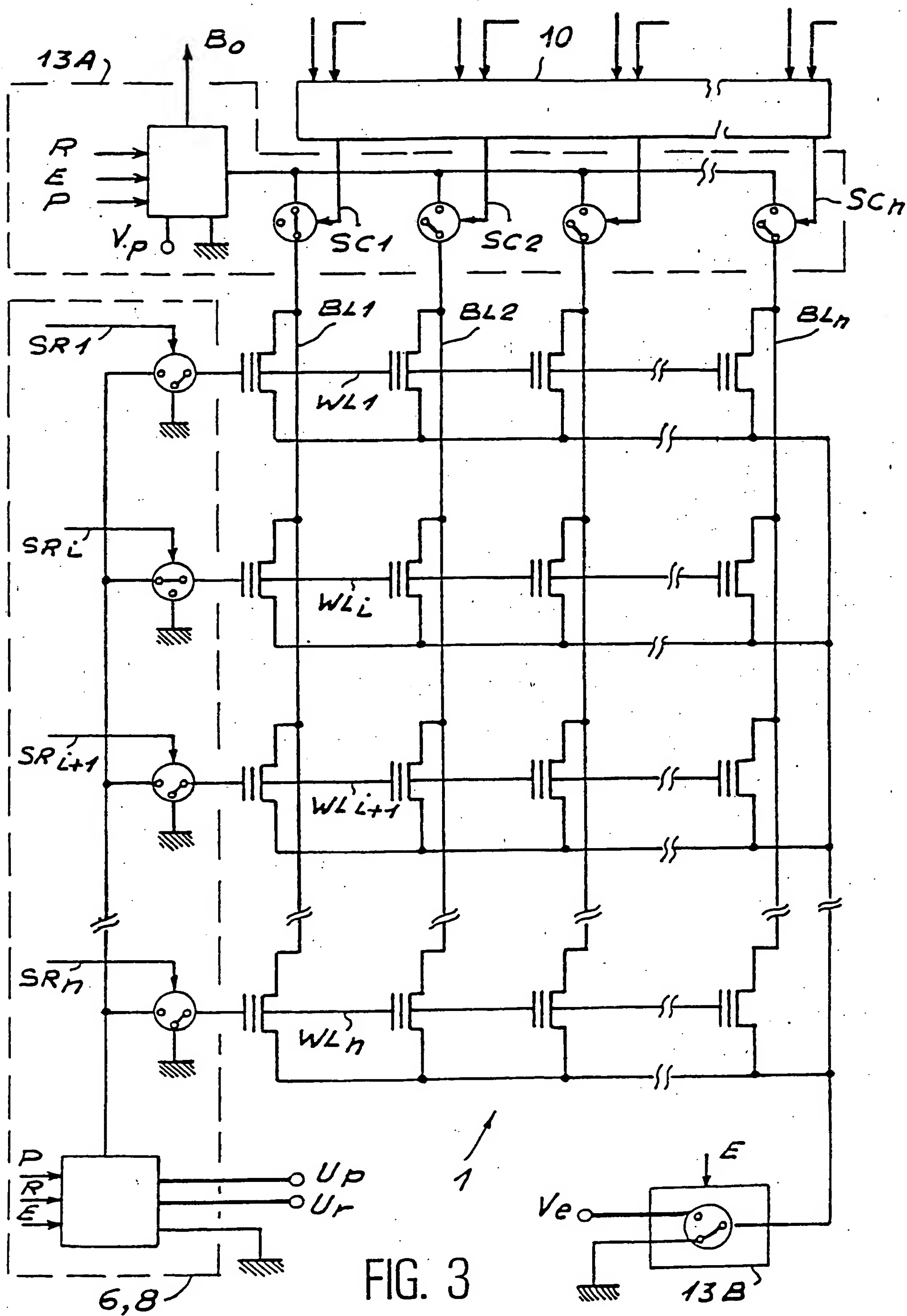
2. Speicher nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Rechenmittel (23) wenigstens eine Inkrementierungsschaltung (23A) enthalten, die eine Ausgangsgröße liefert, die gleich der Summe aus einem Eingangswert und einem Inkrementierungswert (D) ist.
3. Speicher nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Auswahl-schaltung (15A, 16A) eine Inkrementierungsschaltung (23A) enthält, die jedem der anderen zu ersetzenden Elemente zugeordnet ist.
4. Speicher nach einem der Ansprüche 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Inkrementierungsschaltung (23A) aus einer kombinatorischen Logikschaltung gebildet ist, die so beschaffen ist, daß sie die Summe aus einem Eingangswert und einem festen Inkrementierungswert (D) bildet.
5. Speicher nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Auswahl-signale (SR_k , SR_{k+1}) redundante Zeilen wählen, die topologisch benachbart sind, und daß die Auswahl-schaltung eine Sperrschaltung (16A) für die Auswahl-signale (SR_k , SR_{k+1}) enthält.
6. Speicher nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß der gespeicherte besondere Wert (X_i) einem Invalidierungssanzeiger (D_k) zugeordnet ist, der in einer programmierbaren und nichtflüchtigen Speicherzelle enthalten ist, daß dann, wenn sich der Invalidierungsanzeiger in einem ersten logischen Zustand befindet, die Auswahl-signale (SR_k , SR_{k+1}) mit den entsprechenden Vergleichssignalen (HIT_k , HIT_{k+1}) jeweils übereinstimmen, daß dann, wenn sich der Invalidierungsanzeiger (D_k) in einem zweiten logischen Zustand befindet, die Auswahl-signale (SR_k , SR_{k+1}) außer in dem Fall, in dem eine Programmierungsoperation vor der Löschung des Spei-

chers erfolgt, gesperrt sind, wobei in diesem Fall die Rechenmittel (23) so gesteuert werden, daß sie einen Wert liefern, der mit dem Eingangswert übereinstimmt.

FIG. 1







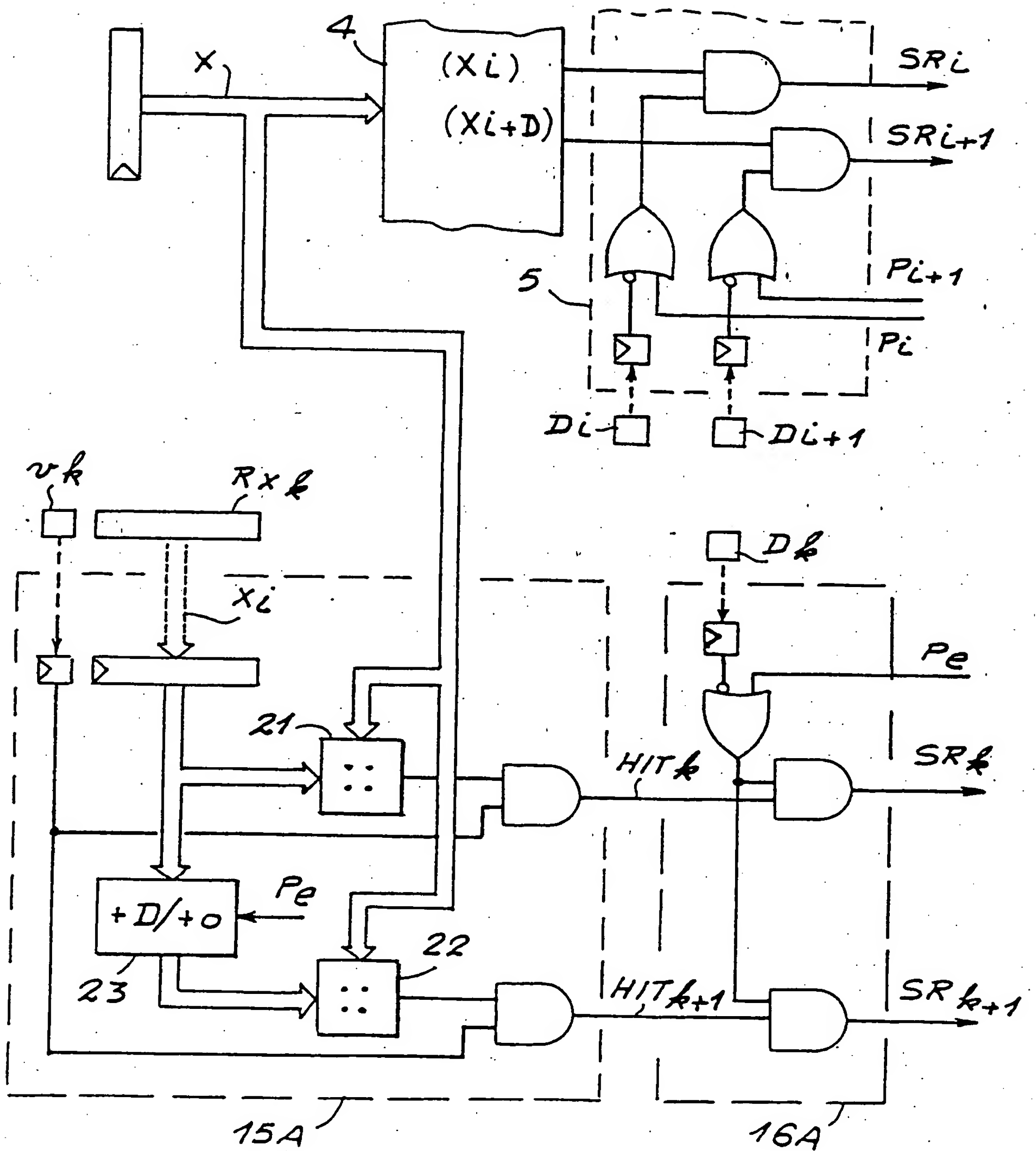


FIG. 4